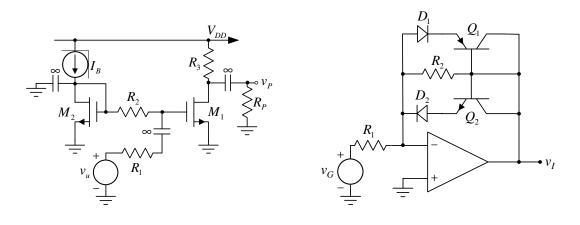
ODSEK ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ODSEK ZA SIGNALE I SISTEME ODSEK ZA FIZIČKU ELEKTRONIKU

1. Za pojačavač sa slike 1 je poznato: $V_{DD}=3,3{\rm V}$, $R_1=50\Omega$, $R_2=5{\rm k}\Omega$, $R_3=1,2{\rm k}\Omega$ i $R_P=1{\rm k}\Omega$. Poznate su i vrednosti sledećih parametara tranzistora: $V_{T1}=V_{T2}=V_T=0,7{\rm V}$, $B_1=11{\rm mA/V}^2$, $B_2=1,1{\rm mA/V}^2$ i $\lambda_1=\lambda_2\to 0$.

- a) [4] Odrediti struje drejna oba tranzistora u mirnoj radnoj tački ako je ukupna snaga koju u kolo ulaže baterija za napajanje u mirnoj radnoj tački 3,63mW.
- b) [4] Odrediti naponsko pojačanje pojačavača $a = v_p / v_u$.
- c) [2] Odrediti ulaznu otpornost pojačavača i otpornost koju vidi potrošač.
- **2.** a) [5] Nacrtati diferencijalni pojačavač sa NMOSFET-ovima na ulazu, strujnim ogledalom sa odgovarajućim MOSFET-ovima za svođenje na jednostruki izlaz i Wilson-ovim strujnim izvorom sa odgovarajućim MOSFET-ovima za zadavanje struja polarizacije ulaznih NMOSFET-ova.
 - b) [2] Izračunati faktor potiskivanja srednje vrednosti signala za pojačavač iz tačke a).
 - c) [3] Pojačavaču iz tačke a) dodati odgovarajući pojačavački stepen sa bipolarnim tranzistorom radi maksimalnog smanjenja izlazne impedanse i izračunati izlaznu impedansu modifikovanog pojačavača.
- 3. a) [3] Nacrtati pojačavač snage u klasi AB sa kvazikomplementarnim Darlingtonovim parovima bipolarnih tranzistora (npn/npn tranzistori u jednom Darlingtonovom paru i pnp/npn tranzistori u drugom Darlingtonovom paru) napajan iz dve baterije za napajanje $V_{CC} = -V_{EE}$.
 - b) [2] Nacrtati funkciju prenosa pojačavača iz tačke a).
 - c) [3] Dodati kolo za zaštitu pojačavača iz tačke a), koje ograničava maksimalnu struju potrošača.
 - d) [2] Na dijagramu napona i struja potrošača (V_P, I_P) ucrtati oblast dozvoljenih napona i struja potrošača za zaštićen pojačavač iz tačke c).

4. [10] Operacioni pojačavač u kolu sa slike 4 je idealan i napaja se iz dve baterije za napajanje $V_{CC} = -V_{EE} = 5 \text{ V}$, diode su idealne sa $V_D = 0,7 \text{ V}$, dok su parametri tranzistora $\left|V_{BE}\right| = \left|V_{BES}\right| = 0,7 \text{ V}$, $\left|V_{CES}\right| = 0,2 \text{ V}$ i $\beta_F = 100$. Poznato je i $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$. Odrediti i nacrtati karakteristiku $v_I = v_I(v_G)$, ako se ulazni napon v_G menja u granicama $-3 \text{ V} \leq v_G \leq 3 \text{ V}$.



Slika 1 Slika 4

Studenti koji polažu drugi kolokvijum rade zadatke 3 i 4 u trajanju do 2 sata. Studenti koji polažu kompletan ispit rade sve zadatke u trajanju do 3 sata.